

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年10月29日(29.10.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/217401 A1

(51) 国際特許分類:

H01L 25/065 (2006.01) H01L 25/18 (2006.01)
H01L 25/07 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2019/017701

(22) 国際出願日: 2019年4月25日(25.04.2019)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 日立化成株式会社(HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.) [JP/JP]; 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 矢羽田 達也 (YAHATA Tatsuya); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番

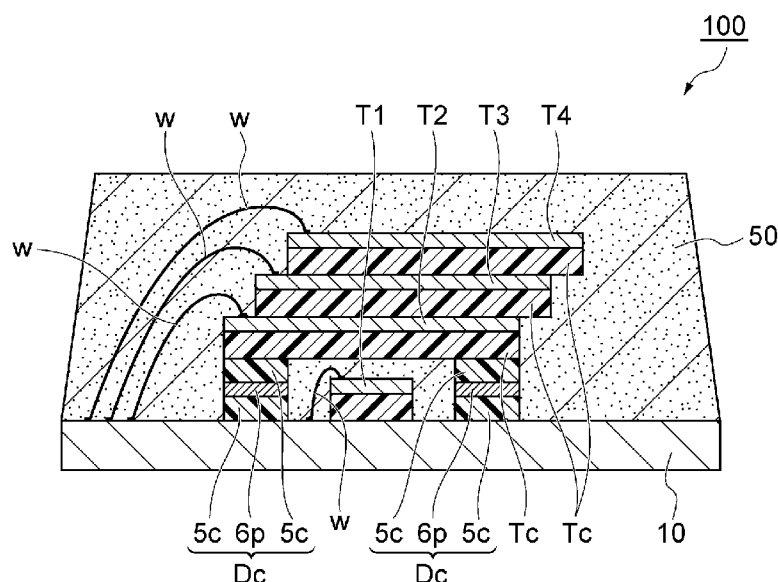
2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP). 谷口 紘平(TANIGUCHI Kouhei); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP). 橋本 慎太郎(HASHIMOTO Shintaro); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP). 尾崎 義信(OZAKI Yoshinobu); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP). 板垣 圭(ITAGAKI Kei); 〒1006606 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 日立化成株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE HAVING DOLMEN STRUCTURE, METHOD FOR MANUFACTURING SAME, LAMINATED FILM FOR FORMING SUPPORT PIECE, AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: ドルメン構造を有する半導体装置及びその製造方法、並びに、支持片形成用積層フィルム及びその製造方法

[図1]



(57) Abstract: A laminated film for forming a support piece according to this disclosure is provided with, in this order, a base material film, a pressure-sensitive adhesive layer, and a support piece-forming film, wherein the support piece-forming film has a multilayer structure including at least a metal layer. The laminated film for forming a support piece is

(明治安田生命ビル) 9階 創英国際特
許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

applied in a process for manufacturing a semiconductor device having a dolmen structure comprising a substrate, a first chip disposed on the substrate, a plurality of support pieces disposed around the first chip on the substrate, and a second chip which is supported by the plurality of support pieces and disposed so as to cover the first chip.

(57) 要約: 本開示に係る支持片形成用積層フィルムは、基材フィルムと、感圧接着層と、支持片形成用フィルムとをこの順序で備え、支持片形成用フィルムが金属層を少なくとも含む多層構造を有する。この支持片形成用積層フィルムは、基板と、基板上に配置された第一のチップと、基板上であって第一のチップの周囲に配置された複数の支持片と、複数の支持片によって支持され且つ第一のチップを覆うように配置された第二のチップとを含むドルメン構造を有する半導体装置の製造プロセスに適用される。

明 細 書

発明の名称：

ドルメン構造を有する半導体装置及びその製造方法、並びに、支持片形成用積層フィルム及びその製造方法

技術分野

[0001] 本開示は、基板と、基板上に配置された第一のチップと、基板上であって第一のチップの周囲に配置された複数の支持片と、複数の支持片によって支持され且つ第一のチップを覆うように配置された第二のチップとを含むドルメン構造を有する半導体装置に関する。また、本開示は、ドルメン構造を有する半導体装置の製造方法、並びに、支持片形成用積層フィルム及びその製造方法に関する。なお、ドルメン（*dolmen*、支石墓）は、石墳墓の一種であり、複数の支柱石と、その上に載せられた板状の岩とを備える。ドルメン構造を有する半導体装置において、支持片が「支柱石」に相当し、第二のチップが「板状の岩」に相当する。

背景技術

[0002] 近年、半導体装置の分野において、高集積、小型化及び高速化が求められている。半導体装置の一態様として、基板上に配置されたコントローラチップの上に半導体チップを積層させる構造が注目を集めている。例えば、特許文献1は、コントローラダイと、コントローラダイの上に支持部材によって支持されたメモリダイとを含む半導体ダイアセンブリを開示している。特許文献1の図1Aに図示された半導体アセンブリ100はドルメン構造を有するということができる。すなわち、半導体アセンブリ100は、パッケージ基板102と、その表面上に配置されたコントローラダイ103と、コントローラダイ103の上方に配置されたメモリダイ106a、106bと、メモリダイ106aを支持する支持部材130a、130bとを備える。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特表2017-515306号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] 特許文献1は、支持部材（支持片）として、シリコンなどの半導体材料を使用できること、より具体的には半導体ウェハをダイシングして得られる半導体材料の断片を使用できることを開示している（特許文献1の[0012]、[0014]及び図2参照）。半導体ウェハを使用してドルメン構造用の支持片を製造するには、通常の半導体チップの製造と同様、例えば、以下の各工程が必要である。

- （1）半導体ウェハにバックグラインドテープを貼り付ける工程
- （2）半導体ウェハをバックグラインドする工程
- （3）ダイシングリングとその中に配置されたバックグラインド後の半導体ウェハに対し、粘着層と接着剤層とを有するフィルム（ダイシング・ダイボンディングー体型フィルム）を貼り付ける工程
- （4）半導体ウェハからバックグラインドテープを剥がす工程
- （5）半導体ウェハを個片化する工程
- （6）半導体チップと接着剤片の積層体からなる支持片を粘着層からピックアップする工程
- （7）複数の支持片を基板の所定の位置に圧着する工程

[0005] 本開示は、ドルメン構造を有する半導体装置の製造プロセスにおいて支持片を作製する工程を簡略化できるとともに、支持片の優れたピックアップ性を達成できる半導体装置の製造方法を提供する。また、本開示は、ドルメン構造を有する半導体装置、並びに支持片形成用積層フィルム及びその製造方法を提供する。

課題を解決するための手段

[0006] 本開示の一側面はドルメン構造を有する半導体装置の製造方法に関する。この製造方法は以下の工程を含む。

- （A）基材フィルムと、感圧接着層と、支持片形成用フィルムとをこの順序

で備える積層フィルムを準備する工程

(B) 支持片形成用フィルムを個片化することによって、感圧接着層の表面上に複数の支持片を形成する工程

(C) 感圧接着層から支持片をピックアップする工程

(D) 基板上に第一のチップを配置する工程

(E) 基板上であって第一のチップの周囲に複数の支持片を配置する工程

(F) 第二のチップと、第二のチップの一方の面上に設けられた接着剤片とを備える接着剤片付きチップを準備する工程

(G) 複数の支持片の表面上に接着剤片付きチップを配置することによってドルメン構造を構築する工程

上記支持片形成用フィルムは金属層を少なくとも含む多層構造を有する。本発明者らの検討によると、金属層を含む支持片形成用フィルムと、紫外線硬化型の粘着層とを併用した場合、支持片形成用フィルムを個片化して得られる支持片のピックアップ性が不十分となる傾向にある。すなわち、例えば、金属層を含む支持片形成用フィルムをブレードで個片化した場合、金属の展性に起因して金属片（金属層が個片化されたもの）のエッジが粘着層に入り込んだ状態となりやすい。その後、紫外線照射によって粘着層が硬化すると金属片のエッジが硬化した粘着層に固定され、これにより支持片のピックアップ性が不十分となる傾向にあると本発明者らは推察する。紫外線硬化型の粘着層の代わりに、感圧接着層（感圧型の粘着層）を採用することで、支持片形成用フィルムが金属層を含む場合であっても、支持片の優れたピックアップ性を達成できる。

[0007] 本開示に係る上記製造方法においては、支持片形成用フィルムを個片化して得られる支持片を使用する。これにより、支持片として、半導体ウェハをダイシングして得られる半導体材料の断片を使用する従来の製造方法と比較すると、支持片を作製する工程を簡略化できる。すなわち、従来、上述の（１）～（７）の工程を必要としていたのに対し、支持片形成用フィルムは半導体ウェハを含まないため、半導体ウェハのバックグラインドに関する（１

）、（２）及び（４）の工程を省略できる。また、樹脂材料と比較して高価な半導体ウェハを使用しないため、コストも削減できる。

[0008] （Ａ）工程で準備する積層フィルムは感圧接着層を有するものであるから、（Ｂ）工程と（Ｃ）工程の間に、感圧接着層に紫外線を照射する工程を実施しなくてよい。

[0009] 支持片形成用フィルムが熱硬化性樹脂層を含む場合、支持片形成用フィルム又は支持片を加熱して熱硬化性樹脂層又は接着剤片を硬化させる工程は適切なタイミングで実施すればよく、例えば、（Ｇ）工程よりも前に実施すればよい。複数の支持片の表面に接するように接着剤片付きチップを配置する段階において、熱硬化性樹脂層が既に硬化していることで接着剤片付きチップの配置に伴って支持片が変形することを抑制できる。なお、熱硬化性樹脂層は他の部材（例えば、基板）に対して接着性を有するため、支持片に接着剤層等を別途設けなくてもよい。

[0010] 本開示の一側面はドルメン構造を有する半導体装置に関する。すなわち、この半導体装置は、基板と、基板上に配置された第一のチップと、基板上であって第一のチップの周囲に配置された複数の支持片と、複数の支持片によって支持され且つ第一のチップを覆うように配置された第二のチップとを含むドルメン構造を有し、支持片が金属片を少なくとも含む多層構造を有する。

[0011] 本開示に係る上記半導体装置は、第二のチップの一方の面上に設けられており且つ第二のチップと複数の支持片とによって挟まれている接着剤片を更に備えてもよい。この場合、上記第一のチップは、接着剤片と離間していてもよいし、接着剤片と接していてもよい。

[0012] 本開示の一側面は支持片形成用積層フィルムに関する。この積層フィルムは、基材フィルムと、感圧接着層と、支持片形成用フィルムとをこの順序で備え、支持片形成用フィルムは金属層を少なくとも含む多層構造を有する。金属層の具体例として、銅層及びアルミニウム層が挙げられる。感圧接着層は、紫外線照射によって硬化するものである必要がないため、光反応性を有

する炭素－炭素二重結合を有する樹脂を含有しなくてよい。なお、感圧接着層は光反応性を有する炭素－炭素二重結合を有する樹脂を含有してもよい。例えば、感圧接着層は、炭素－炭素二重結合を有する樹脂を含む粘着層の所定の領域に紫外線を照射することによって粘着層の当該領域の粘着性を低下させたものであってもよく、光反応性を有する炭素－炭素二重結合を有する樹脂が残存していてもよい。

[0013] 上記支持片形成用フィルムの厚さは、例えば、 $5 \sim 180 \mu\text{m}$ である。支持片形成用フィルムの厚さがこの範囲であることで、第一のチップ（例えば、コントローラチップ）に対して適度な高さのドルメン構造を構築できる。支持片形成用フィルムは熱硬化性樹脂層を含んでもよい。熱硬化性樹脂層は、例えば、エポキシ樹脂を含み、エラストマを含むことが好ましい。支持片を構成する熱硬化性樹脂層がエラストマを含むことで半導体装置内における応力を緩和できる。

[0014] 本開示の一側面は支持片形成用積層フィルムの製造方法に関する。この製造方法は、基材フィルムと、その一方の面上に形成された感圧接着層とを有する粘着フィルムを準備する工程と、感圧接着層の表面上に支持片形成用フィルムを積層する工程とを含み、支持片形成用フィルムは金属層を少なくとも含む多層構造を有する。

[0015] 熱硬化性樹脂層及び金属層を有する支持片形成用積層フィルムは、例えば、以下のように製造することができる。すなわち、この支持片形成用積層フィルムの製造方法は、基材フィルムと、感圧接着層と、熱硬化性樹脂層とをこの順序で備える積層フィルムを準備する工程と、熱硬化性樹脂層の表面に金属層を形成する工程とを含む。

発明の効果

[0016] 本開示によれば、ドルメン構造を有する半導体装置の製造プロセスにおいて支持片を作製する工程を簡略化できるとともに、支持片の優れたピックアップ性を達成できる半導体装置の製造方法が提供される。また、本開示によれば、ドルメン構造を有する半導体装置、並びに支持片形成用積層フィルム

及びその製造方法が提供される。

図面の簡単な説明

[0017] [図1]図 1 は本開示に係る半導体装置の第一実施形態を模式的に示す断面図である。

[図2]図 2 (a) 及び図 2 (b) は第一のチップと複数の支持片との位置関係の例を模式的に示す平面図である。

[図3]図 3 (a) は支持片形成用積層フィルムの一実施形態を模式的に示す平面図であり、図 3 (b) は図 3 (a) の b-b 線における断面図である。

[図4]図 4 は感圧接着層と支持片形成用フィルムとを貼り合わせる工程を模式的に示す断面図である。

[図5]図 5 (a) ~図 5 (d) は支持片の作製過程を模式的に示す断面図である。

[図6]図 6 は基板上であって第一のチップの周囲に複数の支持片を配置した状態を模式的に示す断面図である。

[図7]図 7 は接着剤片付きチップの一例を模式的に示す断面図である。

[図8]図 8 は基板上に形成されたドルメン構造を模式的に示す断面図である。

[図9]図 9 は本開示に係る半導体装置の第二実施形態を模式的に示す断面図である。

[図10]図 10 は支持片形成用積層フィルムの他の実施形態を模式的に示す断面図である。

発明を実施するための形態

[0018] 以下、図面を参照しつつ、本開示の実施形態について詳細に説明する。ただし、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。なお、本明細書において、「(メタ) アクリル酸」とは、アクリル酸又はメタクリル酸を意味し、「(メタ) アクリレート」とは、アクリレート又はそれに対応するメタクリレートを意味する。「A 又は B」とは、A と B のどちらか一方を含んでいればよく、両方とも含んでいてもよい。

[0019] 本明細書において「層」との語は、平面図として観察したときに、全面に

形成されている形状の構造に加え、一部に形成されている形状の構造も包含される。また、本明細書において「工程」との語は、独立した工程だけではなく、他の工程と明確に区別できない場合であってもその工程の所期の作用が達成されれば、本用語に含まれる。また、「～」を用いて示された数値範囲は、「～」の前後に記載される数値をそれぞれ最小値及び最大値として含む範囲を示す。

[0020] 本明細書において組成物中の各成分の含有量は、組成物中に各成分に該当する物質が複数存在する場合、特に断らない限り、組成物中に存在する当該複数の物質の合計量を意味する。また、例示材料は特に断らない限り単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ用いてもよい。また、本明細書中に段階的に記載されている数値範囲において、ある段階の数値範囲の上限値又は下限値は、他の段階の数値範囲の上限値又は下限値に置き換えてもよい。また、本明細書中に記載されている数値範囲において、その数値範囲の上限値又は下限値は、実施例に示されている値に置き換えてもよい。

[0021] <第一実施形態>

(半導体装置)

図1は本実施形態に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。この図に示す半導体装置100は、基板10と、基板10の表面上に配置されたチップT1（第一のチップ）と、基板10の表面上であってチップT1の周囲に配置された複数の支持片Dcと、チップT1の上方に配置されたチップT2（第二のチップ）と、チップT2と複数の支持片Dcとによって挟まれている接着剤片Tcと、チップT2上に積層されたチップT3、T4と、基板10の表面上の電極（不図示）とチップT1～T4とをそれぞれ電氣的に接続する複数のワイヤwと、チップT1とチップT2との隙間等に充填された封止材50とを備える。

[0022] 本実施形態においては、複数の支持片Dcと、チップT2と、支持片DcとチップT2との間に位置する接着剤片Tcとによって基板10上にドルメン構造が構成されている。チップT1は、接着剤片Tcと離間している。支

持片D cの厚さを適宜設定することで、チップT 1の上面と基板1 0とを接続するワイヤwのためのスペースを確保することができる。

[0023] 基板1 0は、有機基板であってもよく、リードフレーム等の金属基板であってもよい。基板1 0は、半導体装置1 0 0の反りを抑制する観点から、基板1 0の厚さは、例えば、9 0～3 0 0 μ mであり、9 0～2 1 0 μ mであってもよい。

[0024] チップT 1は、例えば、コントローラチップであり、接着剤片T cによって基板1 0に接着され且つワイヤwによって基板1 0と電氣的に接続されている。平面視におけるチップT 1の形状は、例えば矩形（正方形又は長方形）である。チップT 1の一辺の長さは、例えば、5 mm以下であり、2～5 mm又は1～5 mmであってもよい。チップT 1の厚さは、例えば、1 0～1 5 0 μ mであり、2 0～1 0 0 μ mであってもよい。

[0025] チップT 2は、例えば、メモリチップであり、接着剤片T cを介して支持片D cの上に接着されている。平面視でチップT 2は、チップT 1よりも大きいサイズを有する。平面視におけるチップT 2の形状は、例えば矩形（正方形又は長方形）である。チップT 2の一辺の長さは、例えば、2 0 mm以下であり、4～2 0 mm又は4～1 2 mmであってもよい。チップT 2の厚さは、例えば、1 0～1 7 0 μ mであり、2 0～1 2 0 μ mであってもよい。なお、チップT 3，T 4も、例えば、メモリチップであり、接着剤片T cを介してチップT 2の上に接着されている。チップT 3，T 4の一辺の長さは、チップT 2と同様であればよく、チップT 3，T 4の厚さもチップT 2と同様であればよい。

[0026] 支持片D cは、チップT 1の周囲に空間を形成するスペーサーの役割を果たす。支持片D cは、二つの接着剤片5 cと、これらに挟まれた金属片6 pとによって構成されている。接着剤片5 cは熱硬化性樹脂組成物（接着剤片5 p）の硬化物からなる。金属片6 pは金属材料（例えば、銅又はアルミニウム）からなる。なお、図2（a）に示すように、チップT 1の両側の離れた位置に、二つの支持片D c（形状：長方形）を配置してもよいし、図2（

b) に示すように、チップ T 1 の角に対応する位置にそれぞれ一つの支持片 D c (形状：正方形、計 4 個) を配置してもよい。平面視における支持片 D c の一辺の長さは、例えば、20 mm 以下であり、1 ~ 20 mm 又は 1 ~ 12 mm であってもよい。支持片 D c の厚さ (高さ) は、例えば、10 ~ 180 μ m であり、20 ~ 120 μ m であってもよい。

[0027] (支持片の作製方法)

支持片の作製方法の一例について説明する。なお、図 1 に示す支持片 D c は、これに含まれる接着剤片 (熱硬化性樹脂組成物) が硬化した後のものである。一方、支持片 D a は、これに含まれる接着剤片 (熱硬化性樹脂組成物) が完全に硬化する前の状態のものである (例えば、図 5 (b) 参照)。

[0028] まず、図 3 (a) 及び図 3 (b) に示す支持片形成用積層フィルム 20 (以下、場合により「積層フィルム 20」という。) を準備する。積層フィルム 20 は、基材フィルム 1 と、感圧接着層 2 と、支持片形成用フィルム D とを備える。基材フィルム 1 は、例えば、ポリエチレンテレフタレートフィルム (PET フィルム) である。感圧接着層 2 は、パンチング等によって円形に形成されている (図 3 (a) 参照)。支持片形成用フィルム D は、パンチング等によって円形に形成されており、感圧接着層 2 よりも小さい直径を有する (図 3 (a) 参照)。支持片形成用フィルム D は、二つの熱硬化性樹脂層 5 と、これらに挟まれた金属層 6 とによって構成されている。

[0029] 熱硬化性樹脂層 5 の厚さは、例えば、5 ~ 180 μ m であり、10 ~ 170 μ m 又は 15 ~ 160 μ m であってもよい。二つの熱硬化性樹脂層 5 の厚さは同じであってもよいし、異なってもよい。金属層 6 は、例えば、銅層又はアルミニウム層である。熱硬化性樹脂層 5 は熱硬化性樹脂組成物からなる。熱硬化性樹脂組成物は、半硬化 (B ステージ) 状態を経て、その後の硬化処理によって完全硬化物 (C ステージ) 状態となり得るものである。熱硬化性樹脂組成物は、エポキシ樹脂と、硬化剤と、エラストマ (例えば、アクリル樹脂) とを含み、必要に応じて、無機フィラー及び硬化促進剤等を更に含む。二つの熱硬化性樹脂層 5 の組成は同じであってもよいし、異なってもよい。

いてもよい。熱硬化性樹脂層 5 を構成する熱硬化性樹脂組成物の詳細については後述する。

[0030] 金属層 6 の厚さは、例えば、 $5 \sim 100 \mu\text{m}$ であり、 $10 \sim 90 \mu\text{m}$ 又は $20 \sim 80 \mu\text{m}$ であってもよい。金属層 6 の厚さが上記範囲であることで、支持片 D a をピックアップする工程において（図 5（d）参照）、金属片 6 p がバネ板のような役割を果たし、優れたピックアップ性を達成できる。また、積層フィルム 20 が金属層 6 を含むことで、樹脂材料と金属材料の光学的なコントラストにより、ピックアップ工程において支持片 D a の優れた視認性を達成し得る。

[0031] 積層フィルム 20 は、例えば、基材フィルム 1 とその表面上に感圧接着層 2 とを有する第 1 の積層フィルムと、カバーフィルム 3 とその表面上に支持片形成用フィルム D とを有する第 2 の積層フィルムとを貼り合わせることで作製することができる（図 4 参照）。第 1 の積層フィルムは、基材フィルム 1 の表面上に感圧接着層を塗工によって形成する工程と、感圧接着層をパンチング等によって所定の形状（例えば、円形）に加工する工程を経て得られる。第 2 の積層フィルムは、カバーフィルム 3（例えば、PET フィルム又はポリエチレンフィルム）の表面上に熱硬化性樹脂層 5 を塗工によって形成する工程と、熱硬化性樹脂層 5 の表面に金属層 6 を形成する工程と、金属層 6 の表面上に熱硬化性樹脂層 5 を塗工によって形成する工程と、これらの工程を経て形成された支持片形成用フィルムをパンチング等によって所定の形状（例えば、円形）に加工する工程を経て得られる。積層フィルム 20 を使用するに際し、カバーフィルム 3 は適当なタイミングで剥がされる。

[0032] 図 5（a）に示されたように、積層フィルム 20 にダイシングリング D R を貼り付ける。すなわち、積層フィルム 20 の感圧接着層 2 にダイシングリング D R を貼り付け、ダイシングリング D R の内側に支持片形成用フィルム D が配置された状態にする。支持片形成用フィルム D をダイシングによって個片化する（図 5（b）参照）。これにより、支持片形成用フィルム D から多数の支持片 D a が得られる。支持片 D a は、二つの接着剤片 5 p と、これ

らに挟まれた金属片 6 p とによって構成される。その後、図 5 (c) に示されるように、基材フィルム 1 をエキスパンドすることで、支持片 D a を互いに離間させる。図 5 (d) に示されるように、支持片 D a を突き上げ治具 4 2 で突き上げることによって感圧接着層 2 から支持片 D a を剥離させるとともに、吸引コレット 4 4 で吸引して支持片 D a をピックアップする。なお、ダイシング前の支持片形成用フィルム D 又はピックアップ前の支持片 D a を加熱することによって、熱硬化性樹脂の硬化反応を進行させておいてもよい。ピックアップする際に支持片 D a が適度に硬化していることで優れたピックアップ性を達成し得る。

[0033] (半導体装置の製造方法)

半導体装置 1 0 0 の製造方法について説明する。本実施形態に係る製造方法は、以下の (A) ~ (H) の工程を含む。

(A) 積層フィルム 2 0 を準備する工程 (図 4 参照)

(B) 支持片形成用フィルム D を個片化することによって、感圧接着層 2 の表面上に複数の支持片 D a を形成する工程 (図 5 (b) 参照)

(C) 感圧接着層 2 から支持片 D a をピックアップする工程 (図 5 (d) 参照)

(D) 基板 1 0 上に第一のチップ T 1 を配置する工程

(E) 基板 1 0 上であって第一のチップ T 1 の周囲に複数の支持片 D a を配置する工程 (図 6 参照)

(F) 第二のチップ T 2 と、第二のチップ T 2 の一方の面上に設けられた接着剤片 T a とを備える接着剤片付きチップ T 2 a を準備する工程 (図 7 参照)

(G) 複数の支持片 D c の表面上に接着剤片付きチップ T 2 a を配置することによってドルメン構造を構築する工程 (図 8 参照)

(H) チップ T 1 とチップ T 2 との間隙等を封止材 5 0 で封止する工程 (図 1 参照)

[0034] (A) ~ (C) 工程は、複数の支持片 D a を作製するプロセスであり、説

明済みである。(D)～(H)工程は、複数の支持片D aを使用してドルメン構造を基板1 0上に構築していくプロセスである。以下、図6～8を参照しながら、(D)～(H)工程について説明する。

[0035] [(D)工程]

(D)工程は、基板1 0上に第一のチップT 1を配置する工程である。例えば、まず、基板1 0上の所定の位置に接着剤層T 1 cを介してチップT 1を配置する。その後、チップT 1はワイヤwで基板1 0と電氣的に接続される。

[0036] [(E)工程]

(E)工程は、基板1 0上であって第一のチップT 1の周囲に複数の支持片D aを配置する工程である。この工程を経て、図6に示す構造体3 0が作製される。構造体3 0は、基板1 0と、その表面上に配置されたチップT 1と、複数の支持片D aとを備える。支持片D aの配置は圧着処理によって行えばよい。圧着処理は、例えば、8 0～1 8 0℃、0. 0 1～0. 5 0 MP aの条件で、0. 5～3. 0秒間にわたって実施することが好ましい。なお、支持片D aは、これに含まれる接着剤片5 pが(E)工程の時点で完全に硬化して支持片D cとなっていていてもよく、この時点では完全硬化していなくてもよい。支持片D aに含まれる接着剤片5 pは(G)工程の開始前の時点で完全硬化して接着剤片5 cとなっていていてもよい。

[0037] [(F)工程]

(F)工程は、図7に示す接着剤片付きチップT 2 aを準備する工程である。接着剤片付きチップT 2 aは、チップT 2と、その一方の表面に設けられた接着剤片T aとを備える。接着剤片付きチップT 2 aは、例えば、半導体ウェハ及びダイシング・ダイボンディングー一体型フィルムを使用し、ダイシング工程及びピックアップ工程を経て得ることができる。

[0038] [(G)工程]

(G)工程は、複数の支持片D cの上面に接着剤片T aが接するように、チップT 1の上方に接着剤片付きチップT 2 aを配置する工程である。具体

的には、支持片D cの上面に接着剤片T aを介してチップT 2を圧着する。この圧着処理は、例えば、80～180℃、0.01～0.50MP aの条件で、0.5～3.0秒間にわたって実施することが好ましい。次に、加熱によって接着剤片T aを硬化させる。この硬化処理は、例えば、60～175℃、0.01～1.0MP aの条件で、5分間以上にわたって実施することが好ましい。これにより、接着剤片T aが硬化して接着剤片T cとなる。この工程を経て、基板10上にドルメン構造が構築される（図8参照）。

[0039] (G) 工程後であって(H) 工程前に、チップT 2の上に接着剤片を介してチップT 3を配置し、更に、チップT 3の上に接着剤片を介してチップT 4を配置する。接着剤片は上述の接着剤片T aと同様の熱硬化性樹脂組成物であればよく、加熱硬化によって接着剤片T cとなる（図1参照）。他方、チップT 2, T 3, T 4と基板10とをワイヤwで電氣的にそれぞれ接続する。なお、チップT 1の上方に積層するチップの数は本実施形態の三つに限定されず、適宜設定すればよい。

[0040] [(H) 工程]

(H) 工程は、チップT 1とチップT 2との隙間等を封止材50で封止する工程である。この工程を経て図1に示す半導体装置100が完成する。

[0041] (熱硬化性樹脂組成物)

熱硬化性樹脂層5を構成する熱硬化性樹脂組成物は、上述のとおり、エポキシ樹脂と、硬化剤と、エラストマとを含み、必要に応じて、無機フィラー及び硬化促進剤等を更に含む。本発明者らの検討によると、支持片D a及び硬化後の支持片D cは以下の特性を有することが好ましい。

・特性1：基板10の所定の位置に支持片D aを熱圧着したとき位置ずれが生じにくいこと（120℃における接着剤片5pの熔融粘度が、例えば、4300～50000Pa・s又は5000～40000Pa・sであること）

・特性2：半導体装置100内において接着剤片5cが応力緩和性を発揮すること（熱硬化性樹脂組成物がエラストマ（ゴム成分）を含むこと）

- ・特性3：接着剤片付きチップの接着剤片T cとの接着強度が十分に高いこと（接着剤片T cに対する接着剤片5 cのダイシエア強度が、例えば、2.0～7.0 Mpa又は3.0～6.0 Mpaであること）
- ・特性4：硬化に伴う収縮率が十分に小さいこと
- ・特性5：ピックアップ工程においてカメラによる支持片D aの視認性が良いこと（熱硬化性樹脂組成物が、例えば、着色料を含んでいること）
- ・特性6：接着剤片5 cが十分な機械的強度を有すること

[0042] [エポキシ樹脂]

エポキシ樹脂は、硬化して接着作用を有するものであれば特に限定されない。ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、ビスフェノールS型エポキシ樹脂等の二官能エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂等のノボラック型エポキシ樹脂などを使用することができる。また、多官能エポキシ樹脂、グリシジルアミン型エポキシ樹脂、複素環含有エポキシ樹脂または脂環式エポキシ樹脂など、一般に知られているものを適用することができる。これらは一種を単独で使用してもよいし、二種以上を併用してもよい。

[0043] [硬化剤]

硬化剤として、例えば、フェノール樹脂、エステル化合物、芳香族アミン、脂肪族アミン及び酸無水物が挙げられる。これらのうち、高いダイシエア強度を達成する観点から、フェノール樹脂が好ましい。フェノール樹脂の市販品として、例えば、DIC（株）製のLF-4871（商品名、BPAノボラック型フェノール樹脂）、エア・ウォーター（株）製のHE-100C-30（商品名、フェニルアラキル型フェノール樹脂）、DIC（株）製のフェノライトKA及びTDシリーズ、三井化学（株）製のミレックスXLC-シリーズとXLシリーズ（例えば、ミレックスXLC-LL）、エア・ウォーター（株）製のHEシリーズ（例えば、HE100C-30）、明和化成（株）製のMEHC-7800シリーズ（例えばMEHC-7800-4S）、JEFケミカル（株）製のJDPPシリーズが挙げられる。これらは

一種を単独で使用してもよいし、二種以上を併用してもよい。

[0044] エポキシ樹脂とフェノール樹脂の配合量は、高いダイシェア強度を達成する観点から、それぞれエポキシ当量と水酸基当量の当量比が0.6～1.5であることが好ましく、0.7～1.4であることがより好ましく、0.8～1.3であることが更に好ましい。配合比が上記範囲内であることで、硬化性及び流動性の両方を十分に高水準に達成しやすい。

[0045] [エラストマ]

エラストマとして、例えば、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、シリコン樹脂、ポリブタジエン、アクリロニトリル、エポキシ変性ポリブタジエン、無水マレイン酸変性ポリブタジエン、フェノール変性ポリブタジエン及びカルボキシ変性アクリロニトリルが挙げられる。

[0046] 高いダイシェア強度を達成する観点から、エラストマとしてアクリル系樹脂が好ましく、更に、グリシジルアクリレート又はグリシジルメタクリレート等のエポキシ基又はグリシジル基を架橋性官能基として有する官能性モノマーを重合して得たエポキシ基含有（メタ）アクリル共重合体等のアクリル系樹脂がより好ましい。アクリル系樹脂のなかでもエポキシ基含有（メタ）アクリル酸エステル共重合体及びエポキシ基含有アクリルゴムが好ましく、エポキシ基含有アクリルゴムがより好ましい。エポキシ基含有アクリルゴムは、アクリル酸エステルを主成分とし、主として、ブチルアクリレートとアクリロニトリル等の共重合体、エチルアクリレートとアクリロニトリル等の共重合体などからなる、エポキシ基を有するゴムである。なお、アクリル系樹脂は、エポキシ基だけでなく、アルコール性又はフェノール性水酸基、カルボキシル基等の架橋性官能基を有していてもよい。

[0047] アクリル樹脂の市販品としては、ナガセケムテック（株）製のSG-70L、SG-708-6、WS-023 EK30、SG-280 EK23、SG-P3溶剤変更品（商品名、アクリルゴム、重量平均分子量：80万、Tg：12℃、溶剤はシクロヘキサノン）等が挙げられる。

[0048] アクリル樹脂のガラス転移温度（ T_g ）は、高いダイシェア強度を達成する観点から、 $-50\sim 50^{\circ}\text{C}$ であることが好ましく、 $-30\sim 30^{\circ}\text{C}$ であることがより好ましい。アクリル樹脂の重量平均分子量（ M_w ）は、高いダイシェア強度を達成する観点から、 $10\text{万}\sim 300\text{万}$ であることが好ましく、 $50\text{万}\sim 200\text{万}$ であることがより好ましい。ここで、 M_w は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（GPC）で測定し、標準ポリスチレンによる検量線を用いて換算した値を意味する。なお、分子量分布の狭いアクリル樹脂を用いることにより、高弾性の接着剤片を形成できる傾向にある。

[0049] 熱硬化性樹脂組成物に含まれるアクリル樹脂の量は、高いダイシェア強度を達成する観点から、エポキシ樹脂及びエポキシ樹脂硬化剤の合計 100 質量部に対して $10\sim 200$ 質量部であることが好ましく、 $20\sim 100$ 質量部であることがより好ましい。

[0050] [無機フィラー]

無機フィラーとして、例えば、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、ホウ酸アルミウイスカ、窒化ホウ素及び結晶性シリカ、非晶性シリカが挙げられる。これらは一種を単独で使用してもよいし、二種以上を併用してもよい。

[0051] 無機フィラーの平均粒径は、高いダイシェア強度を達成する観点から、 $0.005\mu\text{m}\sim 1.0\mu\text{m}$ が好ましく、 $0.05\sim 0.5\mu\text{m}$ がより好ましい。無機フィラーの表面は、高いダイシェア強度を達成する観点から、化学修飾されていることが好ましい。表面を化学修飾する材料として適したものにシランカップリング剤が挙げられる。シランカップリング剤の官能基の種類として、例えば、ビニル基、アクリロイル基、エポキシ基、メルカプト基、アミノ基、ジアミノ基、アルコキシ基、エトキシ基が挙げられる。

[0052] 高いダイシェア強度を達成する観点から、熱硬化性樹脂組成物の樹脂成分 100 質量部に対して、無機フィラーの含有量は $20\sim 200$ 質量部である

ことが好ましく、30～100質量部であることがより好ましい。

[0053] [硬化促進剤]

硬化促進剤として、例えば、イミダゾール類及びその誘導体、有機リン系化合物、第二級アミン類、第三級アミン類、及び第四級アンモニウム塩が挙げられる。高いダイシェア強度を達成する観点から、イミダゾール系の化合物が好ましい。イミダゾール類としては、2-メチルイミダゾール、1-ベンジル-2-メチルイミダゾール、1-シアノエチル-2-フェニルイミダゾール、1-シアノエチル-2-メチルイミダゾール等が挙げられる。これらは一種を単独で使用してもよいし、二種以上を併用してもよい。

[0054] 熱硬化性樹脂組成物における硬化促進剤の含有量は、高いダイシェア強度を達成する観点から、エポキシ樹脂及びエポキシ樹脂硬化剤の合計100質量部に対して0.04～3質量部が好ましく、0.04～0.2質量部がより好ましい。

[0055] <第二実施形態>

図9は第二実施形態に係る半導体装置を模式的に示す断面図である。第一実施形態に係る半導体装置100はチップT1が接着剤片Tcと離間している態様であったのに対し、本実施形態に係る半導体装置200はチップT1が接着剤片Tcと接している。つまり、接着剤片Tcは、チップT1の上面及び支持片Dcの上面に接している。例えば、支持片形成用フィルムDの厚さを適宜設定することで、チップT1の上面の位置と支持片Dcの上面の位置を一致させることができる。

[0056] 半導体装置200においては、チップT1が基板10に対し、ワイヤボンディングではなく、フリップチップ接続されている。なお、チップT2とともに接着剤片付きチップT2aを構成する接着剤片Taに埋め込まれる構成とすれば、基板10にチップT1がワイヤボンディングされた態様であっても、チップT1が接着剤片Tcと接した状態とすることができる。

[0057] 以上、本開示の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。

[0058] 上記実施形態においては、図3（b）に示すように、三層構造の支持片形成用フィルムDを備える支持片形成用積層フィルム20を例示したが、支持片形成用積層フィルムは二層であっても四層以上であってもよい。図10に示す支持片形成用積層フィルム20Aは、熱硬化性樹脂層5と、金属層6とを有する二層フィルムD2（支持片形成用フィルム）を有する。すなわち、支持片形成用積層フィルム20Aにおいては、感圧接着層2と最外面の金属層6との間に熱硬化性樹脂層5が配置されている。

[0059] 支持片形成用積層フィルム20Aは、例えば、以下の工程を経て製造することができる。

- ・基材フィルム1と、感圧接着層2と、熱硬化性樹脂層5とをこの順序で備える積層フィルムを準備する工程
- ・上記積層フィルムの表面に金属層6を貼り合わせる工程

実施例

[0060] 以下、実施例により本開示について説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

[0061] （ワニスの調製）

以下の材料を使用して支持片形成用フィルムの熱硬化性樹脂層を形成するためのワニスを調製した。

- ・エポキシ樹脂：YDCN-700-10：（商品名、新日鉄住金化学（株）製、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、25℃において固体）13.2質量部
- ・フェノール樹脂（硬化剤）：HE-100C-30：（商品名、エア・ウォーター（株）製、フェニルアラキル型フェノール樹脂）11.0質量部
- ・無機フィラー：アエロジルR972：（商品名、日本アエロジル（株）製、シリカ、平均粒径0.016μm）7.8質量部
- ・エラストマ：SG-P3溶剤変更品（商品名、ナガセケムテックス（株）製、アクリルゴム、重量平均分子量：80万、T_g：12℃、溶剤はシクロヘキサノン）66.4質量部

- ・カップリング剤 1 : A-189 : (商品名、GE東芝(株)製、 γ -メルカプトプロピルトリメトキシシラン) 0.4 質量部
- ・カップリング剤 1 : A-1160 : (商品名、GE東芝(株)製、 γ -ウレイドプロピルトリエトキシシラン) 1.15 質量部
- ・硬化促進剤 : キュアゾール 2PZ-CN : (商品名、四国化成工業(株)製、1-シアノエチル-2-フェニルイミダゾール) 0.03 質量部
- ・溶媒 : シクロヘキサン

[0062] <実施例 1>

上記のとおり、溶媒としてシクロヘキサノンを使用し、ワニスの固形分割合が40質量%となるように調整した。100メッシュのフィルターでワニスをろ過するとともに真空脱泡した。ワニスを塗布するフィルムとして、離型処理が施されたポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム(厚さ $38\mu\text{m}$)を準備した。真空脱泡後のワニスを、PETフィルムの離型処理が施された面上に塗布した。塗布したワニスを、 90°C で5分間、続いて 140°C で5分間の二段階で加熱乾燥した。こうして、Bステージ状態(半硬化状態)の熱硬化性樹脂層をPETフィルムの表面上に形成した。熱硬化性樹脂層の表面に銅箔(厚さ: $18\mu\text{m}$)を 70°C のホットプレート上で貼り付けることによって、図10に示す二層フィルムD2と同様の構成の支持片形成用フィルムをPETフィルムの表面上に作製した。

[0063] 感圧接着層を有する積層フィルム(ダイシングテープ)を以下の手順で準備した。粘着剤には、主モノマーとして2-エチルヘキシルアクリレートとメチルメタクリレートを用い、官能基モノマーとしてヒドロキシエチルアクリレートとアクリル酸を用いたアクリル共重合体を溶液重合法にて得た。この合成したアクリル共重合体の重量平均分子量は40万、ガラス転移点は -38°C であった。このアクリル共重合体100質量部に対し、多官能イソシアネート架橋剤(三菱ケミカル(株)製、商品名マイテックNY730A-T)を10質量部配合した粘着剤溶液を調製し、表面離型処理ポリエチレンテレフタレート(厚さ $25\mu\text{m}$)の上に乾燥時の粘着剤厚さが $10\mu\text{m}$ にな

るよう塗工乾燥した。更に、ポリプロピレン／酢酸ビニル／ポリプロピレンからなる100 μ mのポリオレフィン基材を粘着剤面にラミネートした。この粘着フィルムを室温で2週間放置し十分にエージングを行うことでダイシングテープを得た。

[0064] 上記ダイシングテープの感圧接着層に熱硬化性樹脂層を70℃のホットプレート上でゴムロールを使用して貼り合わせた。これにより、支持片形成用フィルムと、ダイシングテープとの積層体を得た。熱硬化性樹脂層の厚さは25 μ mであった。

[0065] <実施例2>

銅箔（厚さ：18 μ m）の代わりにアルミニウム箔（厚さ25 μ m）を使用したことの他は、実施例1と同様にして、支持片形成用フィルムと、ダイシングテープとの積層体を得た。

[0066] 実施例の支持片形成用フィルムに対して以下の評価を行った。

（1）剥離強度

実施例に係る支持片形成用フィルムを含む積層体を幅25mm、長さ100mmの長さにそれぞれカットして試験片を作製した。感圧接着層と支持片形成用フィルムとの界面の剥離強度（剥離角度：180°、剥離速度：300mm／分）を測定した。各実施例につき、測定を3回ずつ行い、その平均値を以下に示す。

・実施例1…0.4N／25mm

・実施例2…0.4N／25mm

[0067] （2）ピックアップ性

実施例に係る支持片形成用フィルム（形状：直径320mmの円形）と、前記ダイシングテープ（形状：直径335mmの円形）の積層体を準備した。この積層体のダイシングテープにダイシングリングを70℃の条件でラミネートした。ダイサーを用いて支持片形成用フィルムをハイト55 μ mの条件で個片化した。これにより、サイズが10mm×10mmの支持片を得た。この支持片に両面テープ（サイズ：8mm×8mm）の一方の面を貼り付

け、他方の面に治具を貼り付けた。この治具をプッシュプルゲージ（イマダ社製）で引っ張ることによって剥離時の引っ張り力を測定した。各実施例につき、測定を5回ずつ行い、その平均値を以下に示す。

・実施例1…4. 4 N / 25 mm

・実施例2…4. 6 N / 25 mm

産業上の利用可能性

[0068] 本開示によれば、ドルメン構造を有する半導体装置の製造プロセスにおいて支持片を作製する工程を簡略化できるとともに、支持片の優れたピックアップ性を達成できる半導体装置の製造方法が提供される。また、本開示によれば、ドルメン構造を有する半導体装置、並びに支持片形成用積層フィルム及びその製造方法が提供される。

符号の説明

[0069] 1…基材フィルム、2…感圧接着層、5…熱硬化性樹脂層、5c…接着剤片（硬化物）、5p…接着剤片、6…金属層、6p…金属片、10…基板、20, 20A…支持片形成用積層フィルム、50…封止材、100, 200…半導体装置、D…支持片形成用フィルム、D2…二層フィルム（支持片形成用フィルム）、Da, Dc…支持片、T1…第一のチップ、T2…第二のチップ、T2a…接着剤片付きチップ、Ta, Tc…接着剤片

請求の範囲

- [請求項1] 基板と、前記基板上に配置された第一のチップと、前記基板上であって前記第一のチップの周囲に配置された複数の支持片と、前記複数の支持片によって支持され且つ前記第一のチップを覆うように配置された第二のチップとを含むドルメン構造を有する半導体装置の製造方法であって、
- (A) 基材フィルムと、感圧接着層と、支持片形成用フィルムとをこの順序で備える積層フィルムを準備する工程と、
 - (B) 前記支持片形成用フィルムを個片化することによって、前記感圧接着層の表面上に複数の支持片を形成する工程と、
 - (C) 前記感圧接着層から前記支持片をピックアップする工程と、
 - (D) 基板上に第一のチップを配置する工程と、
 - (E) 前記基板上であって前記第一のチップの周囲に複数の前記支持片を配置する工程と、
 - (F) 第二のチップと、前記第二のチップの一方の面上に設けられた接着剤片とを備える接着剤片付きチップを準備する工程と、
 - (G) 複数の前記支持片の表面上に前記接着剤片付きチップを配置することによってドルメン構造を構築する工程と、
- を含み、
- 前記支持片形成用フィルムが金属層を少なくとも含む多層構造を有する、半導体装置の製造方法。
- [請求項2] (B) 工程と (C) 工程の間に、前記感圧接着層に紫外線を照射する工程を含まない、請求項 1 に記載の半導体装置の製造方法。
- [請求項3] 前記支持片形成用フィルムが熱硬化性樹脂層を含み、
- (G) 工程よりも前に、前記支持片形成用フィルム又は前記支持片を加熱する工程を含む、請求項 1 又は 2 に記載の半導体装置の製造方法。
- [請求項4] 基板と、

前記基板上に配置された第一のチップと、

前記基板上であって前記第一のチップの周囲に配置された複数の支持片と、

前記複数の支持片によって支持され且つ前記第一のチップを覆うように配置された第二のチップと、

を含むドルメン構造を有し、

前記支持片が金属片を少なくとも含む多層構造を有する、半導体装置。

[請求項5] 前記第二のチップの一方の面上に設けられており且つ前記第二のチップと前記複数の支持片とによって挟まれている接着剤片を更に備える、請求項4に記載の半導体装置。

[請求項6] 前記第一のチップが前記接着剤片と離間している、請求項5に記載の半導体装置。

[請求項7] 前記第一のチップが前記接着剤片と接している、請求項5に記載の半導体装置。

[請求項8] 基板と、前記基板上に配置された第一のチップと、前記基板上であって前記第一のチップの周囲に配置された複数の支持片と、前記複数の支持片によって支持され且つ前記第一のチップを覆うように配置された第二のチップとを含むドルメン構造を有する半導体装置の製造プロセスにおいて使用される支持片形成用積層フィルムであって、

基材フィルムと、

感圧接着層と、

支持片形成用フィルムと、

をこの順序で備え、

前記支持片形成用フィルムが金属層を少なくとも含む多層構造を有する、支持片形成用積層フィルム。

[請求項9] 前記金属層が銅層又はアルミニウム層である、請求項8に記載の支持片形成用積層フィルム。

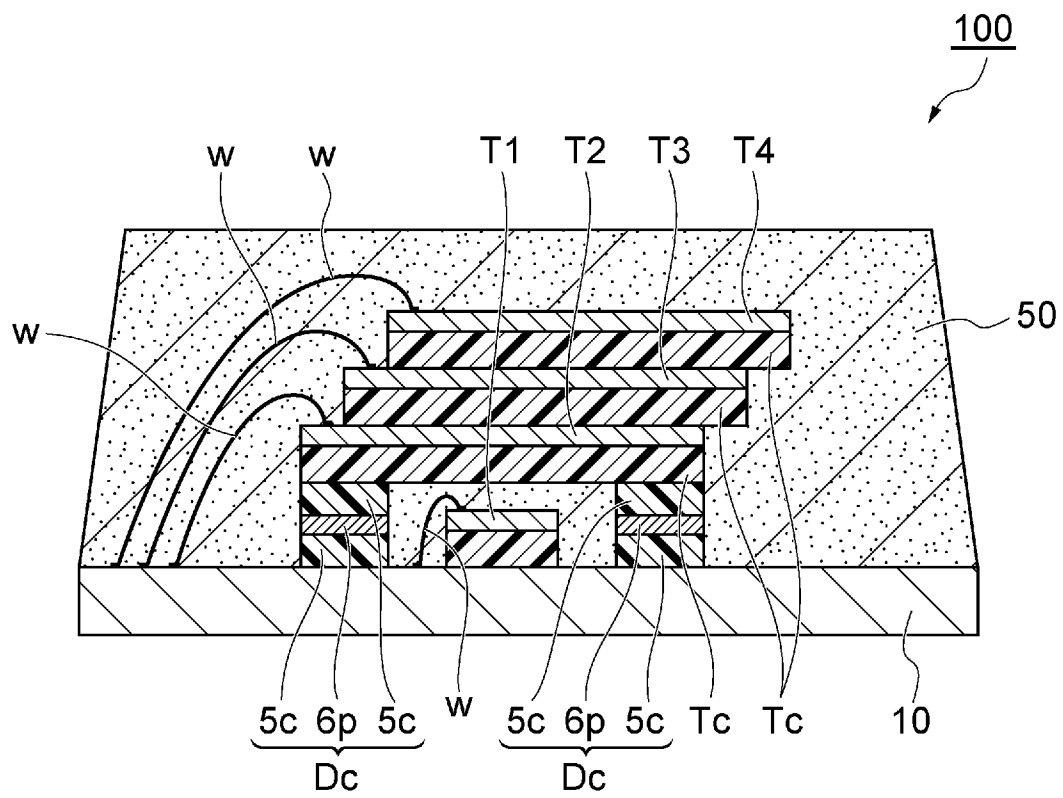
- [請求項10] 前記支持片形成用フィルムの厚さが $5 \sim 180 \mu\text{m}$ である、請求項8又は9に記載の支持片形成用積層フィルム。
- [請求項11] 前記感圧接着層が光反応性を有する炭素－炭素二重結合を有する樹脂を含有しない、請求項8～10のいずれか一項に記載の支持片形成用積層フィルム。
- [請求項12] 前記支持片形成用フィルムが熱硬化性樹脂層を含む、請求項8～11のいずれか一項に記載の支持片形成用積層フィルム。
- [請求項13] 前記熱硬化性樹脂層がエポキシ樹脂を含む、請求項12に記載の支持片形成用積層フィルム。
- [請求項14] 前記熱硬化性樹脂層がエラストマを含む、請求項12又は13に記載の支持片形成用積層フィルム。
- [請求項15] 基板と、前記基板上に配置された第一のチップと、前記基板上であって前記第一のチップの周囲に配置された複数の支持片と、前記複数の支持片によって支持され且つ前記第一のチップを覆うように配置された第二のチップとを含むドルメン構造を有する半導体装置の製造プロセスにおいて使用される支持片形成用積層フィルムの製造方法であって、
基材フィルムと、その一方の面上に形成された感圧接着層とを有する粘着フィルムを準備する工程と、
前記感圧接着層の表面上に支持片形成用フィルムを積層する工程と、
を含み、
前記支持片形成用フィルムが金属層を少なくとも含む多層構造を有する、支持片形成用積層フィルムの製造方法。
- [請求項16] 基板と、前記基板上に配置された第一のチップと、前記基板上であって前記第一のチップの周囲に配置された複数の支持片と、前記複数の支持片によって支持され且つ前記第一のチップを覆うように配置された第二のチップとを含むドルメン構造を有する半導体装置の製造プ

プロセスにおいて使用される支持片形成用積層フィルムの製造方法であって、

基材フィルムと、感圧接着層と、熱硬化性樹脂層とをこの順序で備える積層フィルムを準備する工程と、

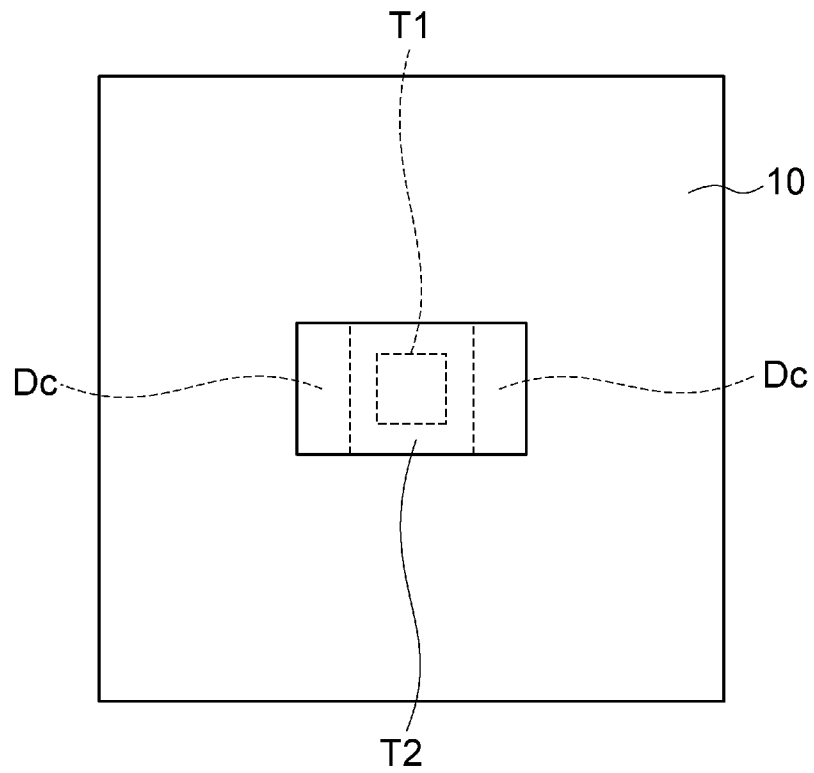
前記熱硬化性樹脂層の表面に金属層を形成する工程と、
を含む、支持片形成用積層フィルムの製造方法。

[図1]

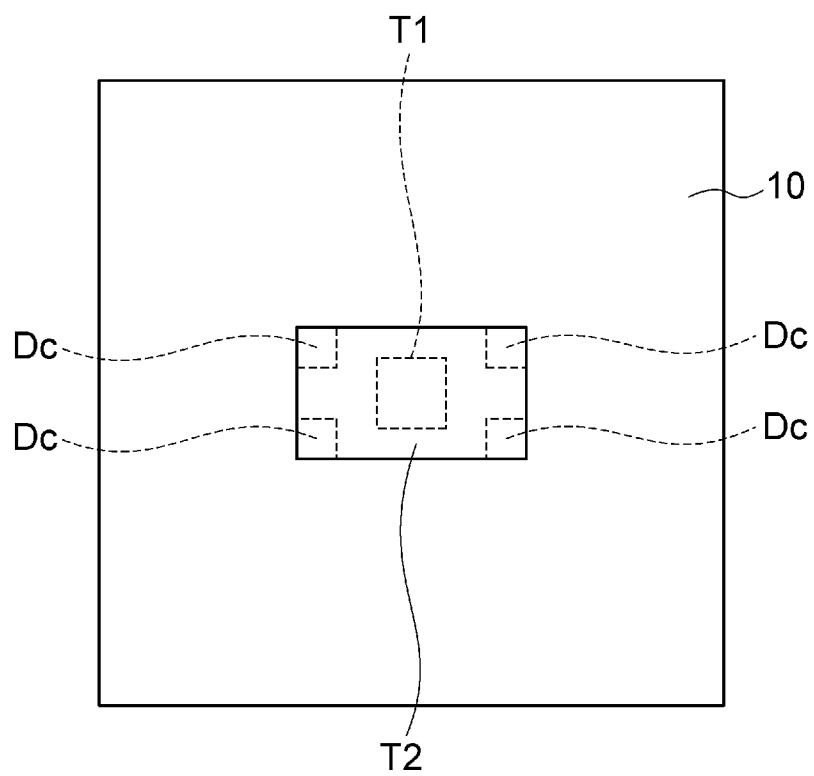


[図2]

(a)

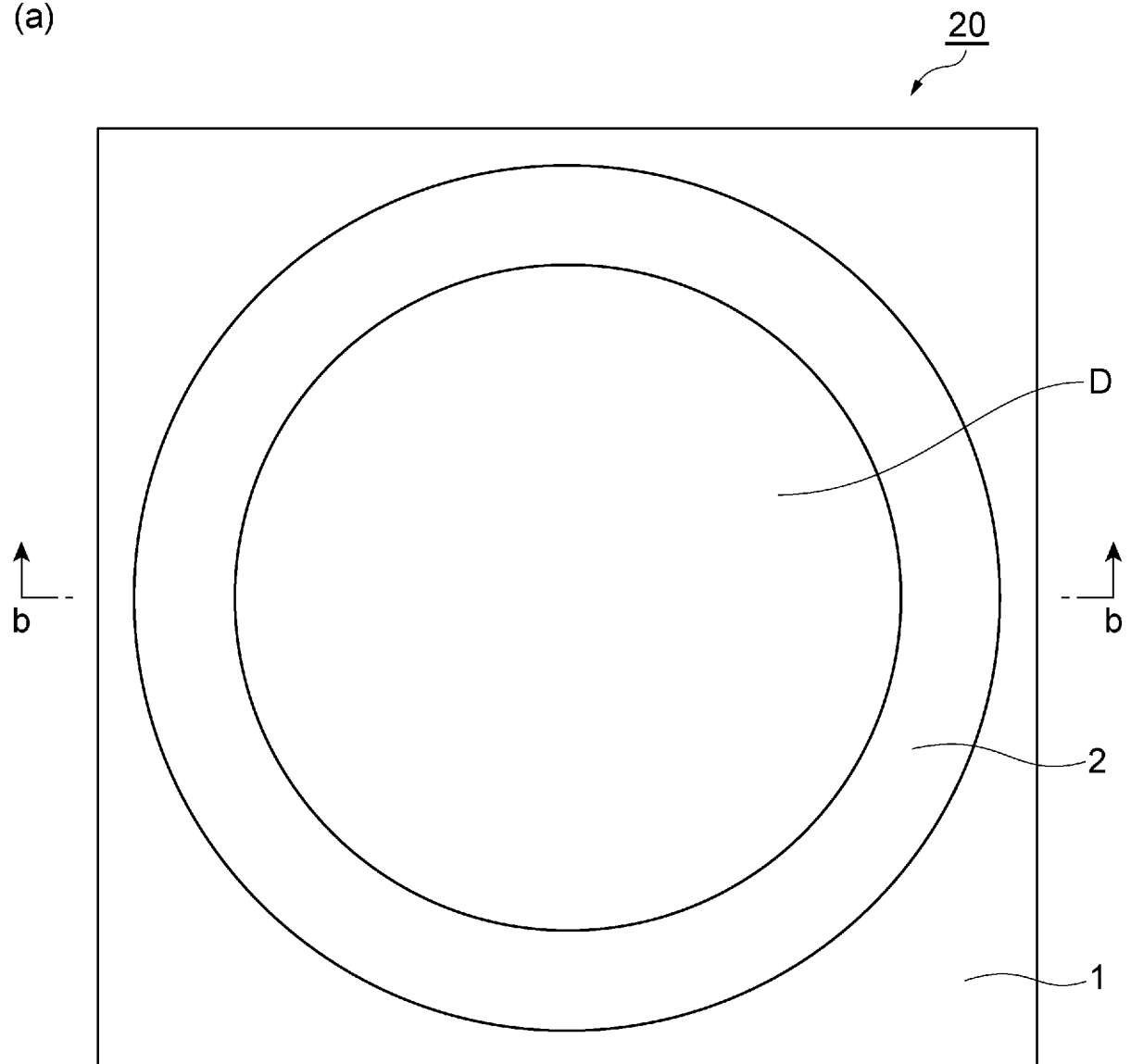


(b)

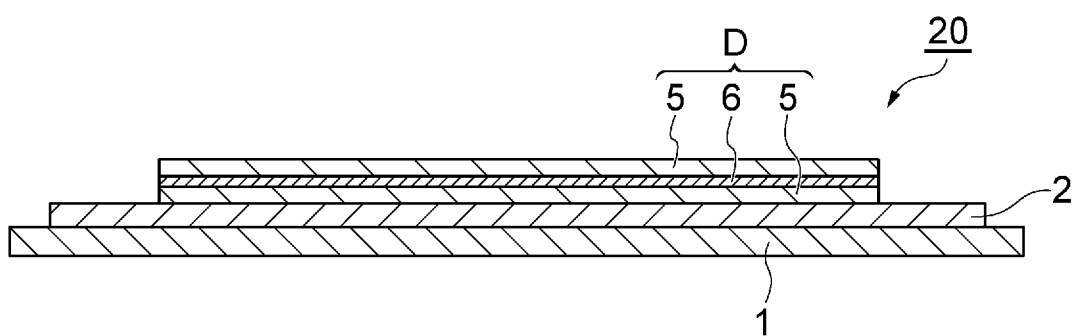


[図3]

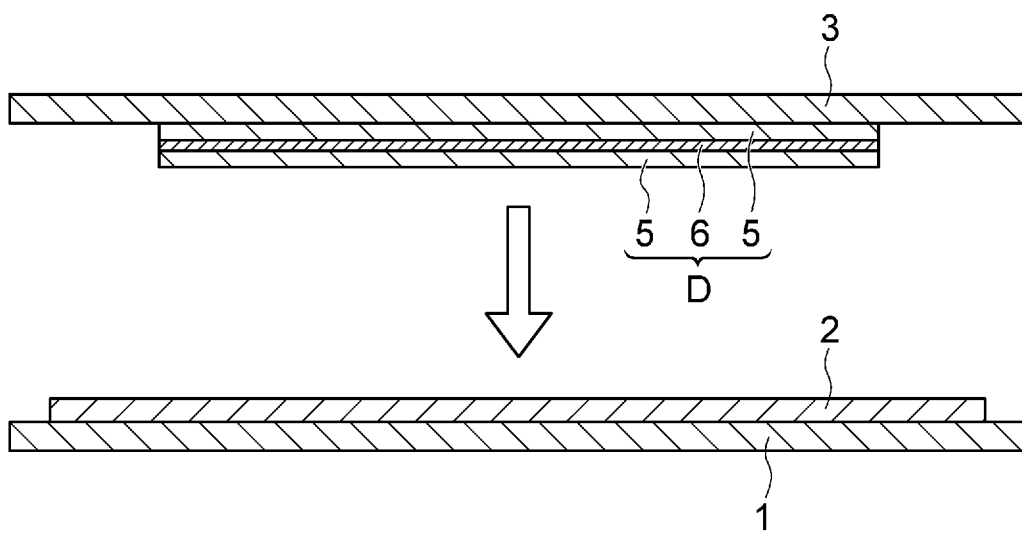
(a)



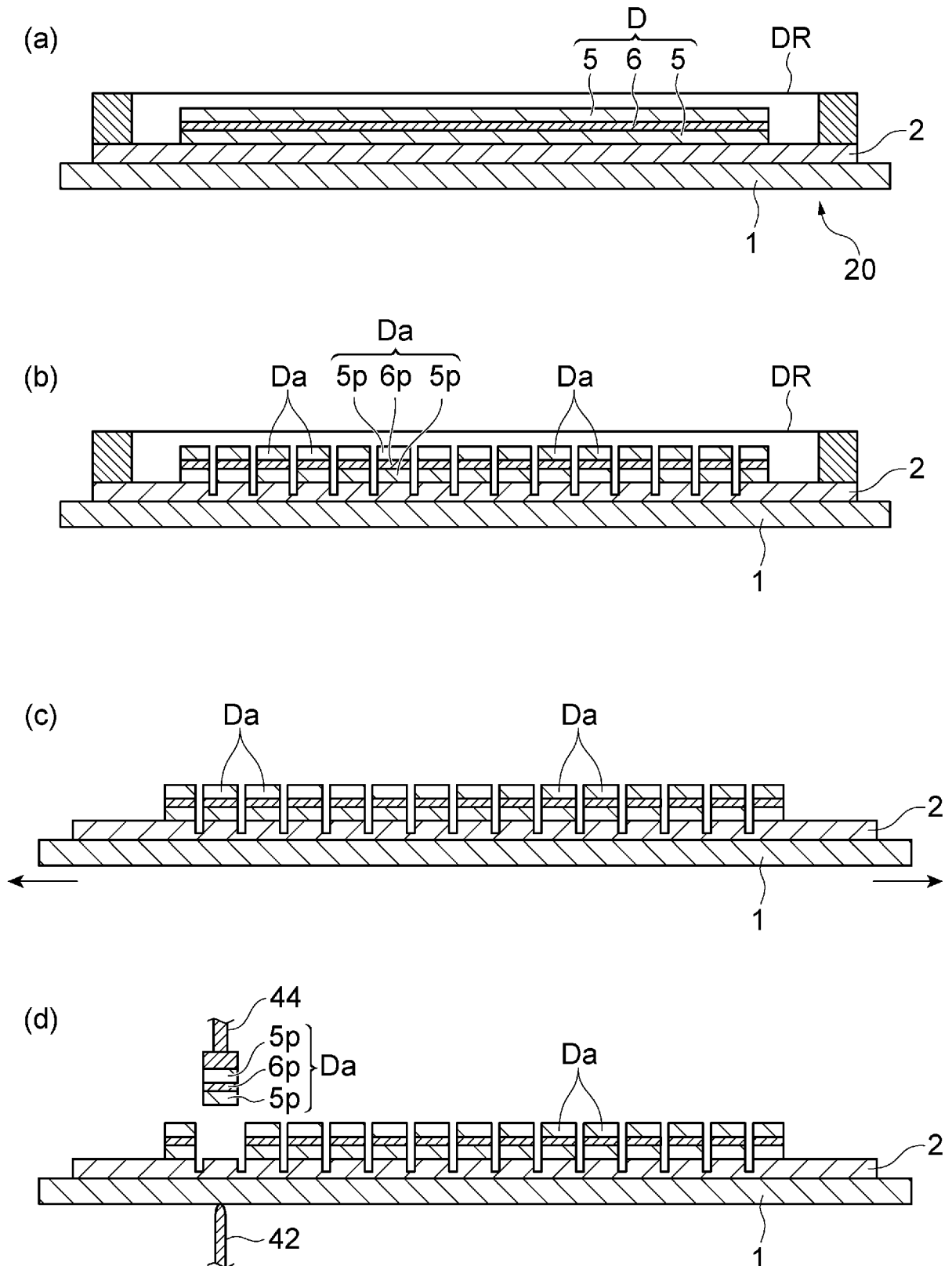
(b)



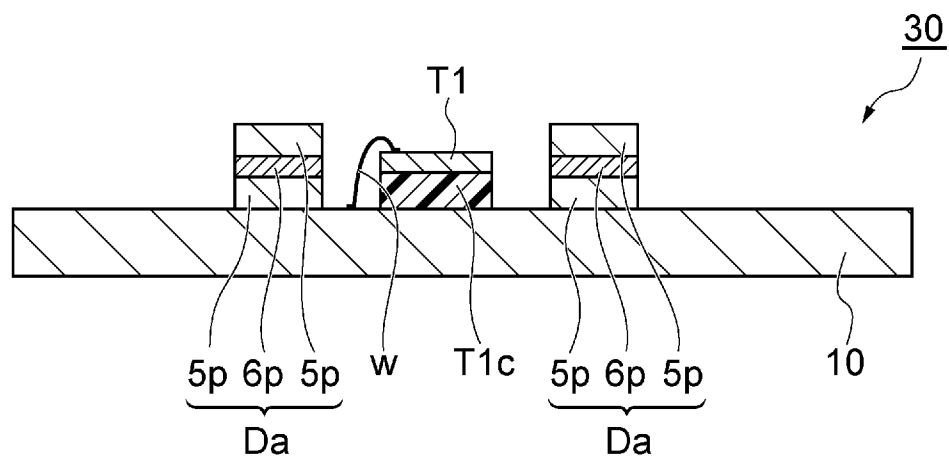
[図4]



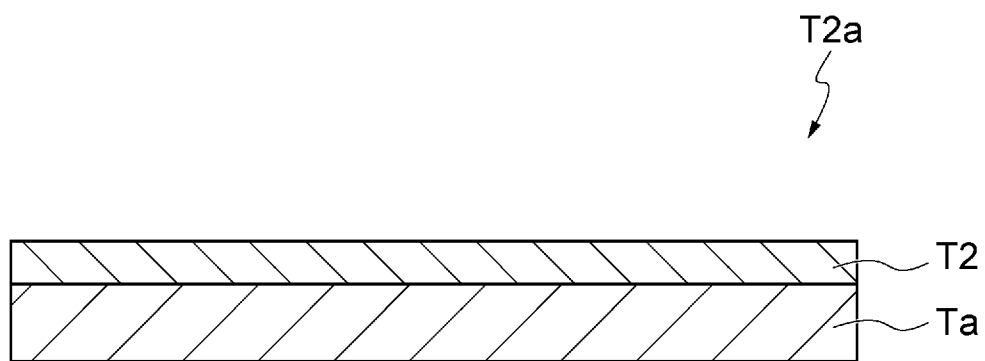
[図5]



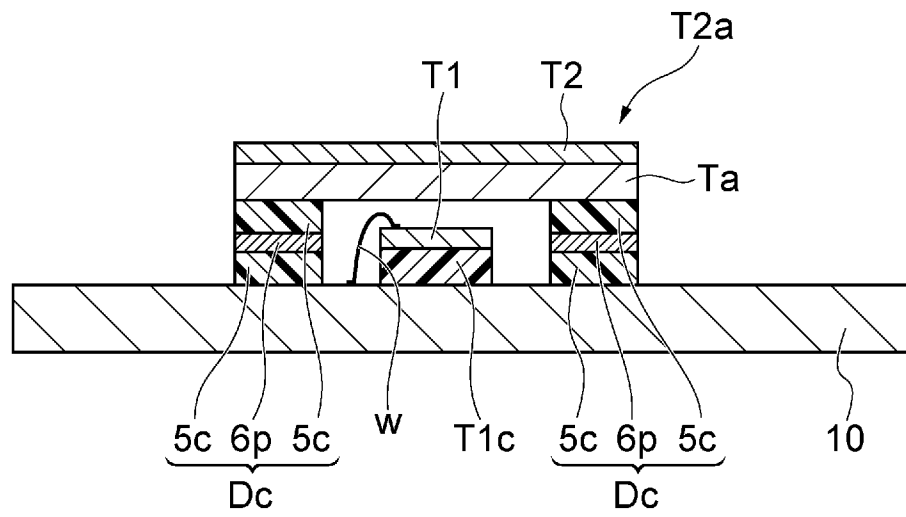
[図6]



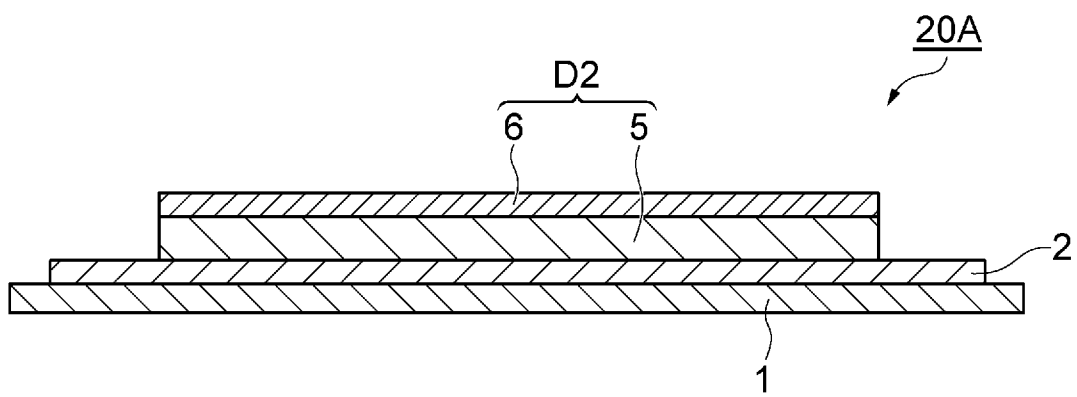
[図7]



[図8]



[図10]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2019/017701

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl. H01L25/065 (2006.01) i, H01L25/07 (2006.01) i, H01L25/18 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. H01L25/065, H01L25/07, H01L25/18

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2019
Registered utility model specifications of Japan	1996-2019
Published registered utility model applications of Japan	1994-2019

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 7859119 B1 (AMKOR TECHNOLOGY, INC.) 28 December 2010, column 4, line 39 to column 9, line 35 (Family: none)	1-5, 7-16
Y	JP 2016-216562 A (NITTO DENKO CORPORATION) 22 December 2016, paragraphs [0071]-[0119], fig. 1-10 & CN 106167683 A & KR 10-2016-0135654 A & TW 201714996 A	1-3, 8-16

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
26.06.2019

Date of mailing of the international search report
09.07.2019

Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2019/017701

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2006-5333 A (TOSHIBA CORPORATION) 05 January 2006, paragraphs [0070]-[0085], fig. 21-24, 26 & US 2006/0139893 A1, paragraphs [0070]-[0085], fig. 21-24, 26 & CN 1700467 A	1-16
Y	JP 2003-124433 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) 25 April 2003, paragraphs [0014]-[0023], fig. 2-9 & US 2003/0038374 A1, paragraphs [0024]-[0034], fig. 2-9 & KR 10-2003-0018204 A	4-6
A	JP 2017-515306 A (MICRON TECHNOLOGY INC.) 08 June 2017, paragraphs [0005]-[0022], fig. 1-7 & US 2015/0311185 A1, paragraphs [0013]-[0028], fig. 1-7 & WO 2015/168206 A1 & TW 201603211 A & CN 106256018 A & KR 10-2016-0144498 A & SG 11201608741T A	1-16
A	JP 2002-222889 A (NEC KYUSHU LTD.) 09 August 2002, paragraphs [0015]-[0021], fig. 1, 2 & US 2002/0096785 A1, paragraphs [0040]-[0054], fig. 1, 2 & KR 10-2002-0062820 A	1-16
A	US 2007/0181990 A1 (SILICONWAVE PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.) 09 August 2007, paragraphs [0033]-[0059], fig. 4-12 & TW 200731503 A	1-16
A	JP 2015-176906 A (TOSHIBA CORPORATION) 05 October 2015, paragraphs [0009]-[0040], fig. 1-5 & CN 104916645 A & TW 201535668 A	1-16
A	US 2008/0029885 A1 (SANDISK IL LTD.) 07 February 2008, paragraphs [0034]-[0040], fig. 4-8 & WO 2008/018058 A1 & TW 200830521 A	1-16
A	US 2013/0270717 A1 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) 17 October 2013, paragraphs [0038]-[0105], fig. 1-23 & KR 10-2013-0117109 A	1-16
A	JP 2013-131557 A (TOSHIBA CORPORATION) 04 July 2013, paragraphs [0009]-[0035], fig. 1-6 & CN 103178036 A	1-16

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. H01L25/065(2006.01)i, H01L25/07(2006.01)i, H01L25/18(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. H01L25/065, H01L25/07, H01L25/18

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2019年
日本国実用新案登録公報	1996-2019年
日本国登録実用新案公報	1994-2019年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	US 7859119 B1 (AMKOR TECHNOLOGY, INC.) 2010.12.28, 第4欄第39行-第9欄第35行（ファミリーなし）	1-5, 7-16
Y	JP 2016-216562 A（日東電工株式会社）2016.12.22, 段落[0071]-[0119], 図1-10 & CN 106167683 A & KR 10-2016-0135654 A & TW 201714996 A	1-3, 8-16

☑ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

26.06.2019

国際調査報告の発送日

09.07.2019

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

平林 雅行

5 F

6310

電話番号 03-3581-1101 内線 3516

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2006-5333 A (株式会社東芝) 2006. 01. 05, 段落[0070]-[0085], 図 21-24, 26 & US 2006/0139893 A1, 段落[0070]-[0085], 図 21-24, 26 & CN 1700467 A	1-16
Y	JP 2003-124433 A (三星電子株式会社) 2003. 04. 25, 段落[0014]-[0023], 図 2-9 & US 2003/0038374 A1, 段落[0024]-[0034], 図 2-9 & KR 10-2003-0018204 A	4-6
A	JP 2017-515306 A (マイクロン テクノロジー, インク.) 2017. 06. 08, 段落[0005]-[0022], 図 1-7 & US 2015/0311185 A1, 段落[0013]-[0028], 図 1-7 & WO 2015/168206 A1 & TW 201603211 A & CN 106256018 A & KR 10-2016-0144498 A & SG 11201608741T A	1-16
A	JP 2002-222889 A (九州日本電気株式会社) 2002. 08. 09, 段落[0015]-[0021], 図 1-2 & US 2002/0096785 A1, 段落[0040]-[0054], 図 1-2 & KR 10-2002-0062820 A	1-16
A	US 2007/0181990 A1 (SILICONWAVE PRECISION INDUSTRIES CO., LTD.) 2007. 08. 09, 段落[0033]-[0059], 図 4-12 & TW 200731503 A	1-16
A	JP 2015-176906 A (株式会社東芝) 2015. 10. 05, 段落[0009]-[0040], 図 1-5 & CN 104916645 A & TW 201535668 A	1-16
A	US 2008/0029885 A1 (SANDISK IL LTD.) 2008. 02. 07, 段落[0034]-[0040], 図 4-8 & WO 2008/018058 A1 & TW 200830521 A	1-16
A	US 2013/0270717 A1 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) 2013. 10. 17, 段落[0038]-[0105], 図 1-23 & KR 10-2013-0117109 A	1-16
A	JP 2013-131557 A (株式会社東芝) 2013. 07. 04, 段落[0009]-[0035], 図 1-6 & CN 103178036 A	1-16